Úkol

- 1. Na internetu najděte katalogové listy všech optoelektronických součástek, které budete v úloze používat, konkrétní měřené součástky vybere vyučující. Parametry důležité ke splnění pracovních úkolů vypište a přiložte do zápisu z měření.
- 2. Změřte voltampérové a světelné charakteristiky dvou luminiscenčních diod v propustném směru. Grafy vytvořte v praktiku, jsou povinnou součástí zápisu z měření.
- 3. Ze změřených V-A charakteristik určete pro jednotlivé diody statický odpor R_d , dynamický odpor R_{di} , hodnotu konstanty n a prahové napětí U^* . Určete, z jakého materiálu jsou jednotlivé diody zhotoveny. Nezapomeňte na graf $\ln(I_F)$ vs. U_F .
- 4. Změřte charakteristiky fototranzistoru při třech různých hladinách osvětlení. Měření proveď te pomocí pikoampérmetru s vestavěným zdrojem Keithley s funkcí ukládání dat do paměti přístroje. Povinnou součástí zápisu z měření jsou grafy naměřených charakteristik, tabulky do protokolu netiskněte.
- 5. Změřte zisk fototranzistoru.

Teorie

Optoelektronické součástky využívají fyzikální vlastnosti polovodičových P-N přechodů. V této úloze studujeme luminiscenční diody, fotodiody a fototranzistor.

Luminiscenční diody LED jsou založeny na emisi fotonů z oblasti P-N přechodu, kterým prochází proud. Voltampérové charakteristiky těchto součástek záleží mimo jiné na geometrii, vlastnostech přechodu a použitém materiálu.

Pro LED diody definujeme sériový statický odpor v pracovním bodě $U_{F_0},\,I_{F_0}$ jako

$$R_d = \frac{U_{F_0}}{I_{F_0}}. (1)$$

Můžeme ho určit lineární regresí lineární části VA závislosti.

Sériový dynamický odpor spočítáme pomocí

$$R_{di} = R_d \frac{nkT}{eU_{F_0}},\tag{2}$$

kde k je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota, e náboj elektronu a n bezrozměrná konstanta popisující výše jmenované vlivy na průběh VA charakteristiky diody.

Tuto konstantu spočteme podle vztahu

$$n = \frac{e}{kT} \frac{U_{F_1} - U_{F_2}}{\ln \frac{I_{F_1}}{I_{F_2}}}. (3)$$

Prahové napětí U^* je takové napětí, při kterém dochází ke zlomu v lineárním průběhu VA charakteristiky, viz [1].

Fotodiody a fototranzistory fungují na principu opačném k principu LED diod. Fotony o vhodné energii dopadají na P-N přechod a vyvolávají vznik elektrického napětí na jeho

vývodech. Fototranzistory se používají pro detekci slabších světelných toků, pro které není fotodioda dostatečně citlivá.

V režimu užívaném v tomto praktiku je závislost fotoelektrického proudu I_{Φ} fotodiodou na světelném toku v širokém rozsahu lineární, kvalitativní vlastnosti se tedy dají usuzovat z průběhu I_{Φ} . Světelnou charakteristikou LED diody proto v tomto praktiku nazýváme závislost fotoelektrického proudu I_{Φ} detektoru na proudu I_{F} protékajícím diodou.

Při zapojení fototranzistoru popsaném v návodu [2] je fotoelektrický proud v kolektoru I_{C0} dán přibližným vztahem

$$I_{C0} = GI_{\Phi},\tag{4}$$

kde G je zisk fototranzistoru a I_{Φ} je primární fotoproud, který získáme zkratováním emitoru s bází.

Voltampérovými charakteristikami fototranzistoru se rozumí závislost I_{C0} na napětí mezi kolektorem a emitorem U_{CE} . Mění se v závislosti na dopadajícím světelném toku.

Výsledky

Úkol 2

Byly měřeny dvě LED diody, červená **LQ1131** a modrá **560LB7D**. Všechny hodnoty byly měřeny automaticky multimetrem **Keithley 6487** s automatickým nastavením rozsahu. Chyby měřicího přístroje nejsou signifikantní vedle chyb lineárních regresí.

Voltampérové charakteristiky zobrazují grafy 1 a 4, světelné charakteristiky grafy 2 a 5.

Úkol 3

Převrácením směrnic lineárních regresí v grafu 1 a 4 byla získána hodnota sériového statického odporu červené resp. modré diody

$$R_d^{\check{c}} = (14,77 \pm 0,20) \,\Omega,$$

$$R_d^m = (17,17 \pm 0,17) \Omega.$$

Lineární regresí v grafu 3 a 6 a použitím vztahu (2) a (3) získáme pro U_{F_0} odpovídající proudu 20 mA hodnoty sériového dynamického odporu

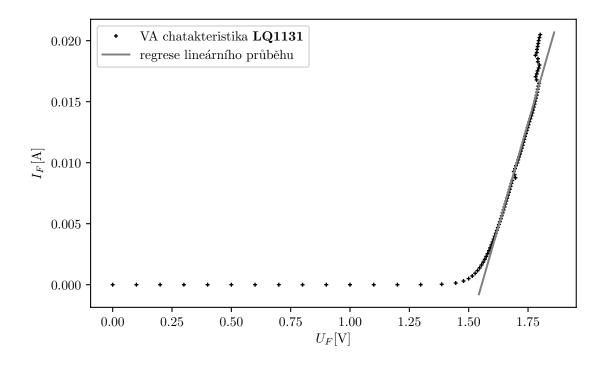
$$R_{di}^{\check{c}} = (0.399 \pm 0.008) \,\Omega,$$

$$R_{di}^m = (0.289 \pm 0.010) \Omega.$$

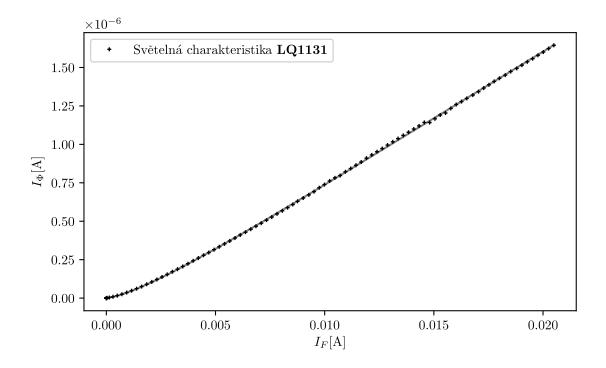
Z lineární regrese v grafech 1 a 4 byly určeny hodnoty

$$U_{\check{c}}^* = (1.55 \pm 0.03) \,\mathrm{V},$$

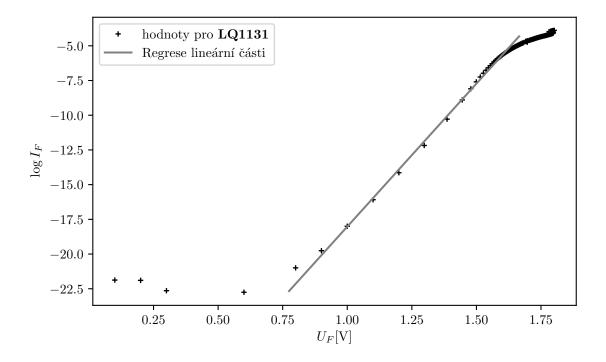
$$U_m^* = (2.77 \pm 0.04) \text{ V}.$$



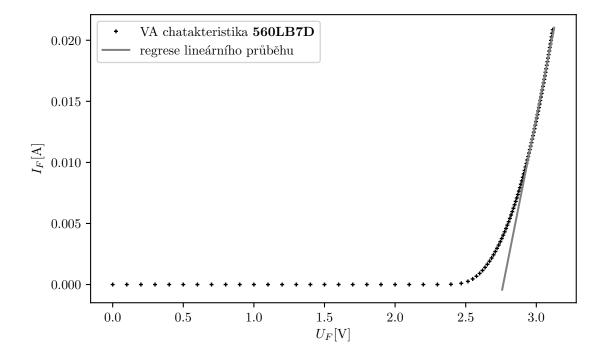
Obrázek 1: Graf voltampérové charakteristiky diody LQ1131



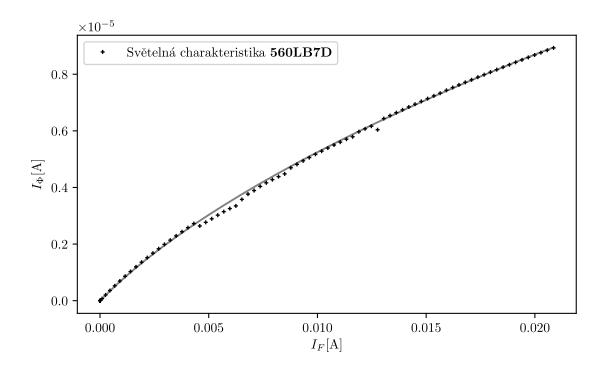
Obrázek 2: Graf světelné charakteristiky diody $\mathbf{LQ1131}$



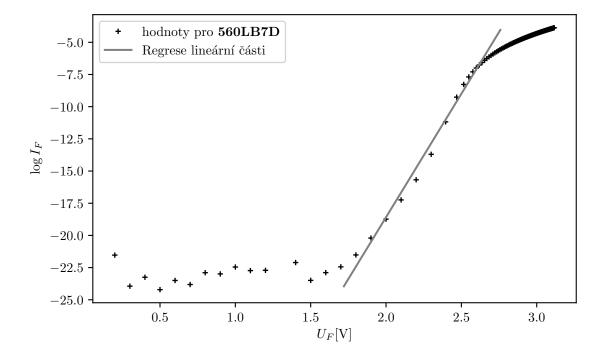
Obrázek 3: Závislost $\log I_F$ na U_F pro diodu $\mathbf{LQ1131}$



Obrázek 4: Graf voltampérové charakteristiky diody 560LB7D



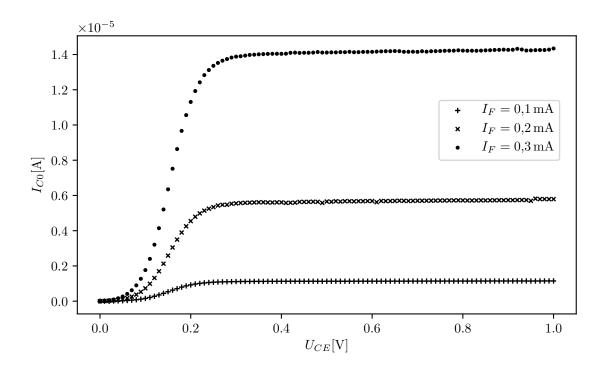
Obrázek 5: Graf světelné charakteristiky diody 560LB7D



Obrázek 6: Závislost $\log I_F$ na U_F pro diodu ${\bf 560LB7D}$

Úkol 4

Následující graf zobrazuje voltampérové charakteristiky fototranzistoru pro osvětlení způsobené proudem I_F protékajícím LED diodou.



Obrázek 7: VA charakteristiky fototranzistoru při různých proudech LED diodou

Úkol 5

Pro získání zisku fototranzistoru byly měřeny hodnoty I_{C0} a I_{Φ} při napětí mezi kolektorem a emitorem $U_{CE}=3\,\mathrm{V}$. Chyby byly odhadnuty z proměnnosti údajů zobrazených na displeji (měřicí přístroj má výrazně větší přesnost).

Při osvětlení fototranzistoru diodou protékanou proudem 0,1 mA byly naměřeny hodnoty

$$I_{\Phi}^{0,1\,\mathrm{mA}} = (8.0\pm0.3)\,\mathrm{nA},$$

$$I_{C0}^{0,1\,\mathrm{mA}} = (1.14\pm0.01)\,\mathrm{\mu A}.$$

Zisk je pak

$$G^{0.1\,\mathrm{mA}} = 143 \pm 6.$$

Při osvětlení fototranzistoru diodou protékanou proudem 0,2 mA byly naměřeny hodnoty

$$I_{\Phi}^{0.2\,\mathrm{mA}} = (29.8 \pm 0.3)\,\mathrm{nA},$$

$$I_{C0}^{0,2\,\mathrm{mA}} = (5.14 \pm 0.05)\,\mu\mathrm{A}.$$

Zisk je pak

$$G^{0,2\,\mathrm{mA}} = 172 \pm 2.$$

Při osvětlení fototranzistoru diodou protékanou proudem 0,3 mA byly naměřeny hodnoty

$$I_{\Phi}^{0,3\,\mathrm{mA}} = (64.2 \pm 0.2)\,\mathrm{nA},$$

$$I_{C0}^{0,3\,\mathrm{mA}} = (14,20\pm0,05)\,\mu\mathrm{A}.$$

Zisk je pak

$$G^{0.3\,\mathrm{mA}} = 221 \pm 1.$$

Diskuse

Mnoho veličin a jejich chyb naměřených v tomto praktiku bylo určeno pomocí lineárních regresí. Protože však měřené průběhy nebyly v celém rozsahu lineární, do zpracování dat vstupuje jistý subjektivní prvek výběru lineární části závislosti pro regresi, tato dodatečná chyba je však jen těžko systematicky zachytitelná. Zároveň jsou u těchto veličin zanedbány chyby způsobené nepřesností měřicího přístroje, které jsou však bez výjimky řádově menší, než chyby lineárních regresí, tudíž by se stejně neprojevily.

Naměřené voltampérové a světelné charakteristiky jakožto i voltampérové charakteristiky vesměs odpovídají teoretickým předpovědím. Je však nutné podotknout, že napříč měřeními se v závislostech nekonzistentně vyskytují drobné nespojitosti a výchylky (viz pravá část grafu 1 či část grafu 5), které neumíme uspokojivě vysvětlit.

Závěr

Naměřené voltampérové a světelné charakteristiky dvou LED diod i voltampérové charakteristiky fototranzistoru kvalitativně odpovídají teoretickým průběhům.

Sériové statické odpory diod jsou

$$R_d^{\check{c}} = (14,77 \pm 0,20) \,\Omega,$$

$$R_d^m = (17,17 \pm 0,17) \,\Omega,$$

sériové dynamické odpory

$$R_{di}^{\check{c}} = (0.399 \pm 0.008) \,\Omega,$$

$$R_{di}^m = (0.289 \pm 0.010) \,\Omega.$$

Prahová napětí jsou

$$U_{\check{c}}^* = (1.55 \pm 0.03) \,\mathrm{V},$$

$$U_m^* = (2.77 \pm 0.04) \,\mathrm{V}.$$

Zisk fototranzistoru je pro tři hodnoty proudu diodou

$$G^{0,1\,\text{mA}} = 143 \pm 6,$$

$$G^{0,2\,\text{mA}} = 172 + 2$$
.

$$G^{0,3\,\text{mA}} = 221 + 1.$$

Reference

- [1] Studijní text "Kvantová optika a optoelektronika", dostupné z http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_305.pdf, 9.3.2018
- [2] Návod "Pokyny k měření pikoampérmetrem", dostupný z http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/pikoampermetr.pdf, 9.3.2018